








	<p>FDS86267P</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS86267P</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 150V</p> <p>Datenblätter:  FDS86267P.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2532 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS86267P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2532 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 2.2A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	255 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1130pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS86267PTR

FDS86267P ist neu im Original, Suche FDS86267P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86267P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS86267P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS86252 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS86540 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 60V 18A 8-SO</p>	 <p>FDS86242 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8- SOIC</p>	 <p>FDS86267P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V</p>
 <p>FDS86242 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8- SOIC</p>	 <p>FDS8638 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS8638-NL F FDS8638-NL F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS8433A	 FDS8433A-NL	 FDS8433A_NL	 FDS8434A-NL	 FDS8435A-NL
 FDS8447-NL	 FDS8447_NL	 FDS8449-NL	 FDS8449_F085	 FDS8449_NL
 FDS86106	 FDS86106	 FDS86106-NL	 FDS86140	 FDS86140
 FDS86141	 FDS86141	 FDS86141-NL	 FDS86240	 FDS86240
 FDS86240-NL	 FDS86242	 FDS86242	 FDS86252	 FDS86252
 FDS86267P	 FDS8638-NL	 FDS86540	 FDS86540	 FDS8670-NL
 FDS8670S-NL	 FDS8670_NL	 FDS8672S	 FDS8672S	 FDS8672S-NL
 FDS8690-NL	 FDS8690C	 FDS8692C	 FDS8812NZ	 FDS8812NZ
 FDS8812NZ-NL	 FDS8813NZ	 FDS8813NZ	 FDS8813NZ-NL	 FDS8817NZ
 FDS8817NZ	 FDS8817NZ-NL	 FDS8840NZ	 FDS8840NZ	 FDS8840NZ-NL

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

